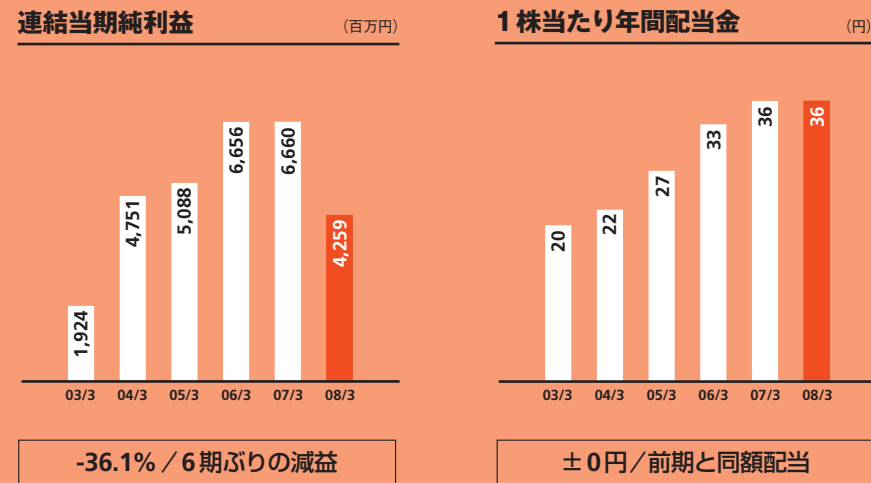
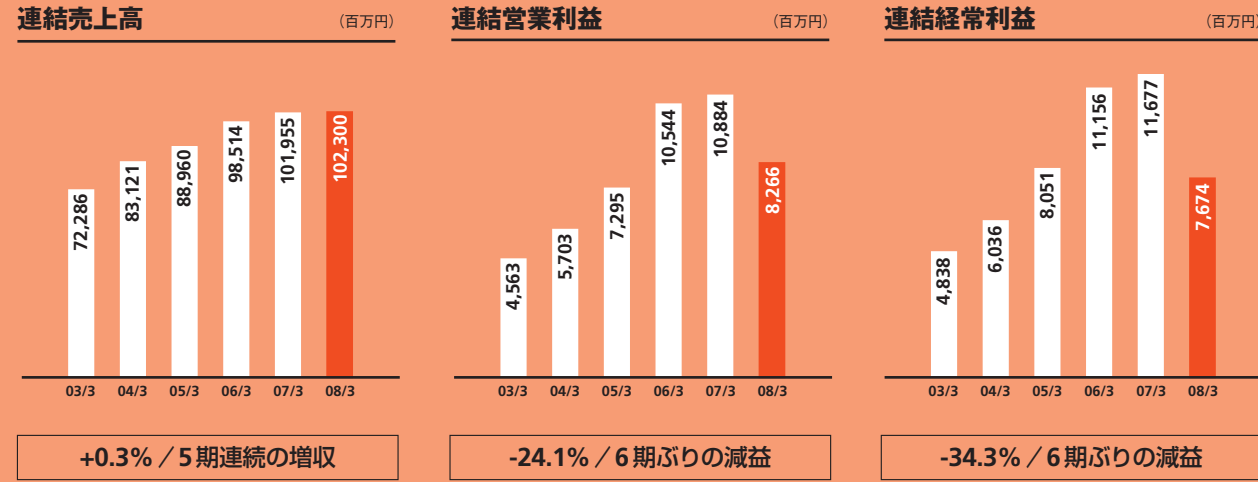


# The Road to the Future

Pioneered by New Technology >>>

# 2008年3月期 財務ハイライト



## Contents

プロフィール	1	財務セクション	14
社長メッセージ	2	● 6年間の要約財務データ	14
特集: 微細加工技術の未来を追求する	6	● 業績および財政状態の分析	15
● 45nm~> 最先端の半導体を支える技術開発	8	● 連結貸借対照表	18
● 32nm~> 次世代技術の展望	10	● 連結損益計算書	20
コーポレート・ガバナンス	12	● 連結株主資本等変動計算書	21
		● 連結キャッシュ・フロー計算書	22
		グローバル・ネットワーク	23
		会社情報	24
		株式の概況	25

## Profile : プロフィール

東京応化は、1940年の設立以来、「技術のたゆまざる研鑽」「製品の高度化」「社会への貢献」「自由闊達」の経営理念の下、エレクトロニクス機能材料をはじめとする材料事業や装置事業の技術・製品の提供を通じて、社会の進歩・発展に貢献してきました。

今後も、調和のとれた未来の創造に向けて「モノづくりを進めると同時に、CSR（企業の社会的責任）を意識した企業活動を展開し、持続的な企業価値の拡大を実現させ、ステークホルダーの皆様から高い信頼と満足を受けられる魅力ある企業であり続けたいと考えています。

### ■ 材料事業

#### エレクトロニクス機能材料

半導体やフラットパネルディスプレイ、半導体パッケージ/実装、プリント基板等の微細加工に必要な材料として広く使用されているフォトレジスト<sup>※</sup>や、半導体の微細化の進展に伴う配線の多層化に対応し層間絶縁膜・平坦化絶縁膜として用いられる被膜形成用塗布液等を提供しています。当社は、より高性能・高品質な製品を開発し供給することで、エレクトロニクス産業発展の一翼を担っています。

<sup>※</sup> フォトレジスト：光に反応して化学的に作用・変化する樹脂で、感光性樹脂とも呼ばれています。

#### 高純度化学薬品

フォトレジストの総合メーカーとして、その特性を熟知しているアドバンテージを生かし、現像液、剥離液、リンス液、シンナー等のフォトレジスト付属薬品も幅広くラインナップしています。さらに、様々な産業分野で利用されている無機・有機化学薬品も取りそろえています。

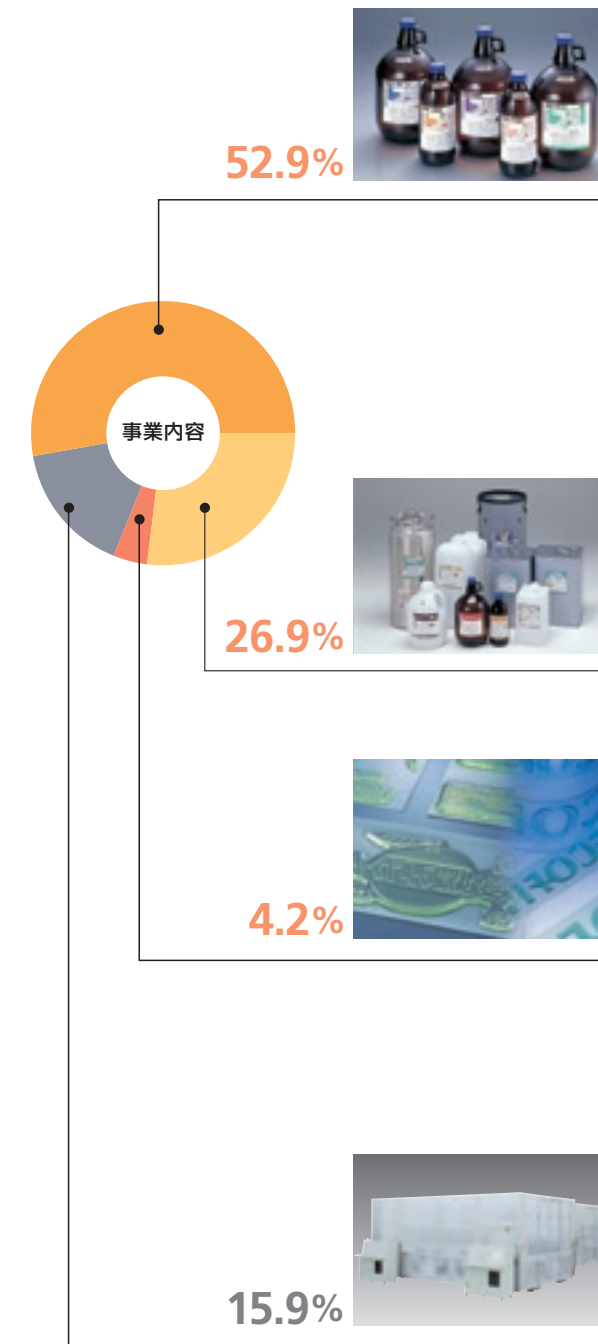
#### 印刷材料

飲料缶や段ボール、フィルム等の凸版印刷に用いられる感光性樹脂版のほか、オフセット印刷に使われるPS版等、幅広く印刷製版材料を提供しています。環境に配慮したフレキシ印刷用感光性樹脂版の開発・改良を積極的に進め、印刷工程における合理化・無公害化・高品質化等のニーズにお応えしています。

### ■ 装置事業

#### プロセス機器

液晶パネル製造用のフォトレジスト塗布・現像装置や各種半導体製造用装置を取りそろえています。これらの装置とフォトレジストをはじめとする材料の両面から製品開発を行い、相乗効果を最大限に引き出すことで、お客様をサポートしています。



<sup>※</sup> 写真左横の数字は連結ベースの売上構成比率です。装置事業につきましては、内部取引を除いています。

## 社長メッセージ

取締役社長  
中村 洋一



### ■ 2008年3月期の業績:

**売上高は微増収を確保するも、利益面は減価償却費の増加、装置事業における貸倒引当金繰入額の計上等の影響により減益**

当期(2008年3月期)の事業環境を振り返りますと、半導体市場は、メモリの過剰供給による価格下落が見られましたが、新型機種デジタル家電や情報関連機器の需要拡大、省エネルギー技術を搭載する自動車への半導体の用途拡大等から安定した成長が続きました。また、フラットパネルディスプレイ(FPD)市場も、販売価格下落の影響がありましたものの、薄型テレビ等の需要拡大に支えられ概ね順調に推移しました。

このような状況の下、材料事業では、半導体製造分野においてきめ細かな販売促進活動を展開し、エキシマレーザー用フォトレジストを中心に実績を伸ばしました。また、半導体用フォトレジスト付属薬品も、アジア、北米地域を中心に売上を伸ばすことができました。FPD製造分野につきましては、アジア地域におけるユーザーニーズを的確に捉え、液晶パネル用ガラス基板の大型化に対応した製品の拡販に努めたことにより、着実な実績をあげることができました。一方、装置事業は、液晶パネルメーカーの設備投資抑制の影響を受け、受注および売上ともに前期を下回りました。

この結果、当期の連結業績について、売上高は、装置事業の減収を材料事業の増収で補い、1,023億円(前期比0.3%増)と、わずかではありますが増収を確保することができました。しかしながら、利益面におきましては、最先端プロセスへの積極的な設備投資を実施したことによる減価償却費の増加や装置事業における貸倒引当金繰入額の計上ならびに為替相場の変動等の影響もあり、営業利益は82億66百万円(同24.1%減)、経常利益は76億74百万円(同34.3%減)、当期純利益は42億59百万円(同36.1%減)と、減益を余儀なくされました。

### ■ 2009年3月期の見通し:

**装置事業の低迷に加え、研究開発費の増加等もあり、減益を予想**

次期(2009年3月期)の事業環境は、半導体市場の成長が期待ほど見込めず、加えて、為替相場の変動、原油価格の高騰、原材料価格の上昇等の不安定要因もあり、予断を許さない状況が続くと予想されます。

当社としては、新技術・新製品の開発に努めるとともに、成長事業領域へ経営資源を集中させ、材料事業においては、エキシマレーザー用フォトレジスト、FPD用フォトレジスト、フォトレジスト付属薬品等の販売拡大および収益力のさらなる向上を図っていきます。装置事業では、売上の減少が見込まれ、苦戦を強いられると想定されますが、液晶パネル製造装置を中心にさらなる受注の確保に注力していきます。

この状況を踏まえ、次期の連結業績について、売上高は1,021億円(当期比0.2%減)、利益面におきましては、装置事業の売上減少による影響に加えて、研究開発費の増加等もあり、営業利益は67億円(同18.9%減)、経常利益は69億円(同10.1%減)、当期純利益は33億円(同22.5%減)を予想しています。

### ■ 第3次中期計画の進捗:

**半導体関連材料はほぼ計画どおりに推移するが、液晶関連材料が低調で数値目標との乖離が顕在化**

2007年3月期にスタートした中期計画第3次「tok チャレンジ21」では、新たな成長ステージへと歩みを進めるため、「微細加工技術の進化」「グローバル市場でのTOKブランドの確立」「経営体質の強化・企業風土改革」を基本戦略に掲げ取り組んできました。しかしながら、中期計画の最終年度となる次期の連結業績は、前述のとおり、当期比で減収減益を予想せざるを得ず、連結数値目標(売上高1,200億円、経常利益153億円)は未達となり、過去最高益(1998年3月期:連結経常利益136億円)の更新も難しい見通しです。

この要因としては、FPD市場が当初の想定ほど拡大せず、販売価格の下落も相まって、とりわけ液晶ディスプレイ(LCD)用フォトレジストおよび付属薬品が伸び悩んでいること、また、税制改正に伴う減価償却費の増加、為替相場の変動、原油価格の高騰等が予想を超えて影響していることなどが挙げられます。

当社としても、それら事業環境の変化に対応すべく経営努力を重ねてきましたが、残念ながら挽回するほどの売上増加を果たすことができず、その点は厳しく受けとめています。

<中期計画策定時の目標値と2009年3月期の予想値の主な差異>

- エキシマレーザー用フォトレジストはほぼ計画どおりの売上増加を見込むが、LCD用フォトレジストの売上増加は目標の3分の1程度にとどまる。
- 高純度化学薬品の売上増加が、LCD用フォトレジスト付属薬品の低迷により目標値を大幅に下回る。
- 装置事業の売上が、受注の低調な推移により目標値を大幅に下回る。

以上のような現状分析に基づき、当社が今後も持続的な企業価値の拡大を図っていくには、売上成長力を高める戦略が必要であると認識しています。

## ■ 今後の方針：

### 既存技術の一層の強化と新技術の開発により、最高益更新に向けた成長基盤の構築を図る

業績の向上により過去最高益を更新し、持続的な企業価値の拡大を目指すには、既存技術を収益事業として一層強化することに加え、新しい技術分野を成長ドライバーとして創出していくことが必要だと考えています。

既存収益事業の強化策として、半導体の微細化により延命、特性向上が求められているKrFエキシマレーザー用フォトレジストの開発を継続し、LCD用フォトレジストにつきましても、価格競争力の強化、顧客基盤の拡大を図っていきます。また、高純度化学薬品は、微細化に伴う半導体製造分野での新たなニーズを捉え、製品の改良、開発を進めます。2008年10月には、米国で半導体用フォトレジスト付属薬品の生産能力増強が完了する予定で、これを契機に北米地域での売上増加に弾みがつくものと期待を寄せています。一方、装置事業においても、買い替え需要を含めて、液晶パネル用ガラス基板の大型化に対応した装置の受注活動に注力していきます。

新たな成長ドライバーとしては、ArFエキシマレーザー用フォトレジストの拡販を図るとともに、半導体製造分野の最先端領域において次世代材料に関する技術を発展させ、液浸露光技術に対するユーザーニーズに応えた製品の開発強化、さらなる微細化の実現に向けた二重露光技術等への対応に力を入れていきます。また、半導体パッケージ分野において将来のキー・テクノロジーとして注目を集めるシリコン貫通電極形成プロセスを可能にするウエハハンドリングシステム「Zero Newton®」の製品開発を材料・装置の両面から進めるほか、環境負荷の少ないエネルギー源として市場の拡大が期待される太陽電池分野での研究開発も行うなど、既存事業領域の枠を越えた展開を積極的に推進します。

これらの諸施策を通じて成果を着実に積み上げ、成長基盤の構築に取り組んでいきます。

## ■ 株主・投資家の皆様へ：

### 成長基盤の構築により、持続的な企業価値の拡大を目指す

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけ、業績や財政状態等を総合的に勘案したうえで、適切かつ積極的な利益還元を実施していきます。配当につきましては、現在の水準を考慮しつつ連結配当性向20%以上を継続することを基本方針としています。なお、当期の1株当たり配当金は、前期と同額の36円とさせていただきます。また、長期的な観点から自己株式の取得も弾力的に実施していきたいと考えています。

今後も厳しい事業環境が続きますが、新技術・新製品の開発を加速させ、成長基盤を確たるものとしたうえで、持続的な企業価値の拡大を目指していきます。

皆様におかれましては、一層のご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

2008年7月

取締役社長

中村洋一



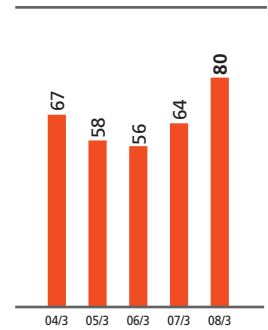
# 特集：微細加工技術の未来を追求する

## ■ 持続的な企業価値の拡大を目指して——微細加工技術を柱とする研究開発

微細加工技術——東京応化にとって、それはコア・コンピタンスであり、企業価値を生み出す本源そのものと言えます。だからこそ、当社は微細加工技術を愚直なまでに追求し続けてきました。そして、未来への飛躍に向けて、その姿勢が揺らぐことはありません。

当社は、成長の原動力となる研究開発に対し経営資源を積極的かつタイムリーに投入し、最先端エレクトロニクス分野における技術開発力の強化を図っています。フォトレジストをはじめとする様々な材料 (Materials) と装置 (Equipment) の両面から開発を行い、他社にない当社の強みの1つである「M&E戦略」を推進することによって、ユーザーニーズを的確に捉えたソリューションの提供を可能にします。また、研究開発のスピード向上と効率化を目的に、装置メーカー、サプライヤー、大学や研究機関等との連携を積極的に進める一方、独自の研究開発によるコア技術の蓄積にもこだわり、分子設計や樹脂合成等、自らの手を使った「モノづくり」の強化に取り組んでいます。

研究開発費の推移 (億円)

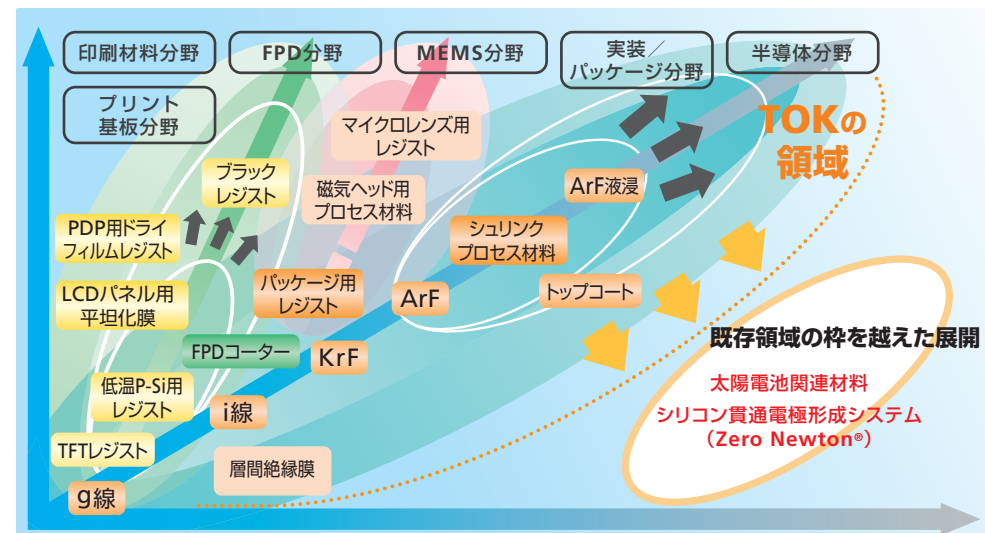


## ■ 「微細加工技術の進化」のために——垂直的展開と水平的展開

第3次中期計画では「微細加工技術の進化」を基本戦略の1つに掲げています。

微細加工技術の“垂直的展開”として、技術を複合的に組み合わせ、より付加価値の高い微細化の提案を行う一方、“水平的展開”として、既存技術の応用と現状にとらわれない発想の転換により、これまでの事業領域の枠を越え、次世代に継承できる新たなビジネスの開拓にも注力しています。

### 微細加工技術の進化



## ■ 技術的優位性の確立に向けて——半導体製造分野における最先端技術の開発

フォトリソグラフィを用いた微細加工技術は幅広い分野で活用されていますが、中でも100nm (1nmは1,000,000分の1mm) 以下の領域にある半導体製造分野は、際立って微細化が進んだ最もチャレンジングな分野であると言えます。

当社では、半導体製造分野の最先端材料に対する研究開発を、微細加工技術の進化に欠くことのできない最重要領域であると位置づけています。この分野・領域における微細加工技術は、当社の“フラッグシップ”であり、また、“アイデンティティ”であると強く認識し、次世代の技術領域でイニシアティブを握り、微細加工技術における優位性を確固たるものにするため、将来を見据えた新技術・新製品の開発を追求していきます。



微細加工を可能にする  
フォトレジスト



微細加工が施された  
シリコンウエハ

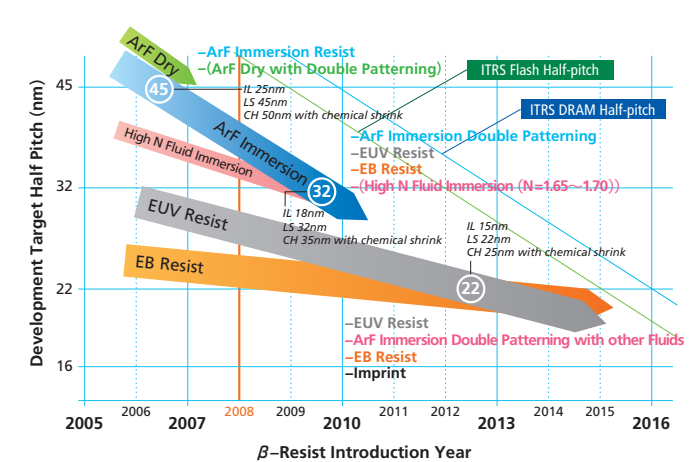
## ■ 微細加工技術のこれから——半導体用フォトレジストの過去・現在・未来

半導体製造における微細化を実現する手段の1つとして、これまで露光光源の短波長化が図られてきました。g線 (436nm) からi線 (365nm)、KrFエキシマレーザー (248nm)、そして、ArFエキシマレーザー (193nm) へと続き、これに伴い回路線幅も縮小化が進んでいます。1990年代前半にg線用フォトレジストで回路線幅700~600nmであったものが、短波長化によって、現在では最先端プロセスにおいて45nmの微細加工が行われています。

回路線幅45nm世代以降の微細化では、露光プロセスの改良によるアプローチとして、液浸露光技術や二重露光技術が提案され、一方で、さらなる短波長化として、EUV (極端紫外線) や電子線等の使用が検討されています。さらに、フォトリソグラフィに代わる工法として、ナノインプリント技術の半導体製造への適用も試みられています。

当社はこれまで、露光光源の移行、露光プロセスの改良に合わせて、フォトレジストをはじめとする材料の最適化を行ってきました。今後もさらなる微細化に貢献するため、ユーザーニーズに合致した製品の開発を継続していきます。

半導体用フォトレジストの開発ロードマップ (2008年7月現在)



45nm~

## >最先端の半導体を支える技術開発

微細化に向けて露光光源の短波長化が進んできた半導体。回路線幅 45nm 世代では、90nm 世代、65nm 世代で実用化されている ArF エキシマレーザーを延命させるため、これに液浸露光技術を組み合わせるアプローチが提案され主流となっています。現在、最先端の半導体製造プロセスでは、この ArF 液浸露光技術を用いて、すでに量産が行われています。

### ■ユーザーニーズを捉え、さらなる製品の高機能化を目指す——液浸露光技術※への対応

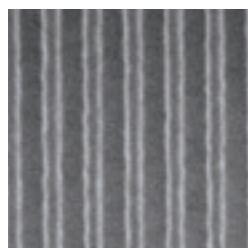
当社は、フォトレジストメーカーとして世界で最初に ArF 液浸露光装置を導入するなど、液浸露光技術に対応するフォトレジストおよび周辺材料の開発にいち早く取り組み、現在量産が行われている最先端の半導体製造プロセスにおいて回路線幅 45nm の実現に貢献しています。

液浸露光技術に対応する ArF エキシマレーザー用フォトレジストのさらなる高機能化に向けて、長年にわたり培ってきた技術を活用することにより、フォトレジストの組成の柱となる樹脂を分子レベルから設計し、酸発生剤も独自に合成するなど、基礎となる原材料から開発を行っています。

また、液浸露光技術では、フォトレジストと純水が接触することで新たな技術的課題も生じるため、これらの解決に向けた材料の開発・改良を進めています。

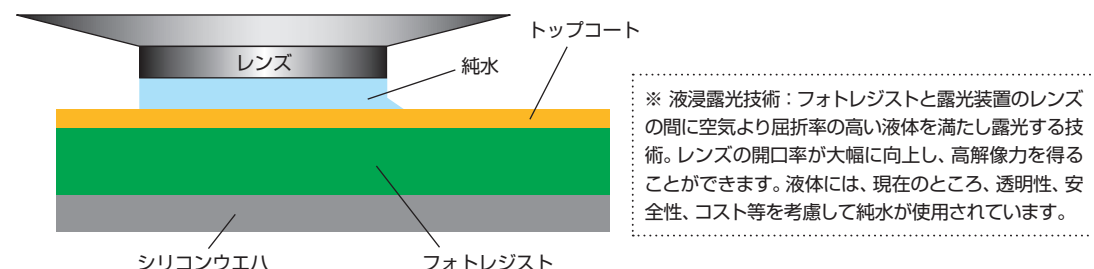


ArF 液浸露光装置



回路線幅 46nm  
(当社の ArF 液浸露光装置を使用)

### 液浸露光技術の概略図

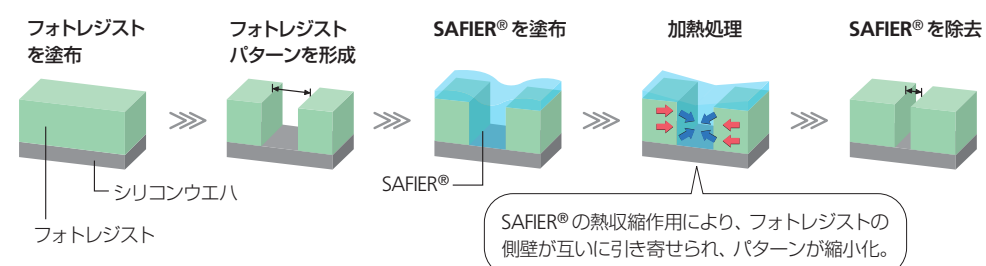


### 一世代先の微細化を可能に——シュリンクプロセス材料「SAFIER®」(サファイア)

当社が開発し製品化したシュリンクプロセス材料「SAFIER®: Shrink Assist Film for Enhanced Resolution」は、既存のフォトレジストと露光装置を使用したままで、一世代先の微細加工を可能にします。

SAFIER®は、その熱収縮作用を利用することでフォトレジストパターンの縮小と形状の改善を同時に実現させるというものです。従来の生産ラインに適用することができるため大規模な投資を必要とせず、既存技術・設備の延命化に貢献することができます。

#### SAFIER®のプロセスフロー



### トップコートの開発

フォトレジストの成分が純水に溶け出してしまうたり、フォトレジストが純水を吸収してしまうたりすることは Defect (欠陥) の発生等につながるため、フォトレジストの表面に保護膜(トップコート)を塗布し、フォトレジストと純水の接触を防ぐ方法が多く採用されています。

当社では、フォトレジストの現像工程で除去できる現像液可溶型トップコートの開発に注力しています。Defect 対策としてトップコート上の純水がスムーズに移動できるように動的撥水性の調整を行い、また、フォトレジストとの良好なマッチング等のニーズにも対応した製品を開発しています。

### トップコートレス・レジストの開発

半導体製造工程およびコストの削減のため、将来的にはトップコートを使わなくても純水の影響を受けにくいフォトレジスト(トップコートレス・レジスト)の開発が要望されています。そこで、酸発生剤の分子構造の改良、フッ素化合物の添加等によりフォトレジスト自体の撥水性を向上させるなど、課題解決に向けた取り組みを強化しています。

### 最新鋭の設備・機器を整備

2006年7月に稼働させた最先端半導体製造用材料の研究開発棟(相模事業所)は、スーパークリーンルーム内に ArF 液浸露光装置のほか、最新鋭の分析・検査機器を取りそろえ、厳格な品質管理要求に応えるための体制を整えています。

2008年3月期には、ArF 露光装置(ドライプロセス)を新たに導入し稼働させました。65nm 世代と 45nm 世代のフォトレジスト開発を分けて行うことで、プロセスごとのニーズをきめ細かく製品開発に反映させ、競争力の強化につなげています。

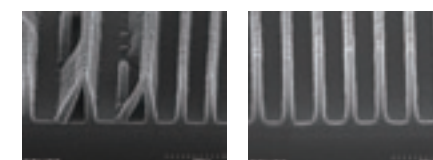


研究開発棟

### パターン倒れと Defect 発生を低減——「ケミカルリンス液」

当社が新たに開発した「ケミカルリンス液」は、フォトレジストパターン形成後の洗浄工程において、従来の純水に代えて用いることにより、パターン倒れの防止と Defect 発生を同時に実現することができます。半導体製造プロセスにおいて、フォトレジストのパターン倒れや Defect の発生は歩留まりの低下を招きます。このケミカルリンス液によってそれらの課題を解決することは、さらなる回路線幅の微細化につながるものと考えています。

#### パターン倒れの抑制効果



純水による洗浄  
(回路線幅 102nm)

ケミカルリンス液による洗浄  
(回路線幅 102nm)

#### シリコンウエハ上の Defect 発生数の比較



純水による洗浄

ケミカルリンス液による洗浄



32nm~

## > 次世代技術の展望

さらに微細化の進んだ次世代領域においては、様々な技術が検討されています。回路線幅 32nm 世代では、ArF 液浸露光装置を用いた二重露光技術の採用が有力視される一方、22nm 世代以降では、EUV (極端紫外線) 露光技術の導入が検討され、また、従来のフォトリソグラフィに代わるナノインプリント技術の適用も提案されています。

### ■「ダブルイメージング技術」で工程数を削減——二重露光技術\*への対応

次世代技術として、回路線幅 32nm 世代の半導体開発においては、既存技術の光学的限界を克服し、すでに実用化されている ArF エキシマレーザーの一層の延命を実現させるための手法が検討されており、ArF 液浸露光装置を用いた二重露光技術の採用が有力視されています。

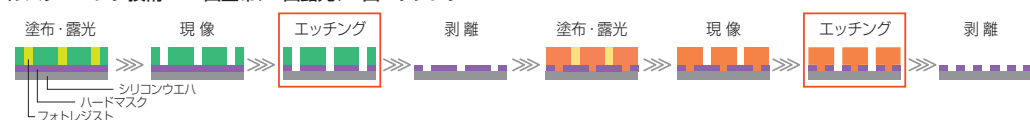
当社は、この二重露光技術で課題となる、エッチング工程を 2 回繰り返すことに伴う作業効率の低下を改善するため、「ダブルイメージング技術」を提唱しています。

ダブルイメージング技術では、はじめにポジ型フォトレジスト\*1でパターンを形成し、次にポジ型フォトレジストあるいはネガ型フォトレジスト\*2を使って残りのパターンを形成した後に、エッチング工程を 1 回だけ行います。エッチング工程が 1 回で済み、また、通常は 1 回目のパターン形成後にフリージング材\*3が用いられるところを、当社独自の手法として、フリージング材を必要としないフォトレジストを使用することで、工程数のさらなる削減を図ることができます。

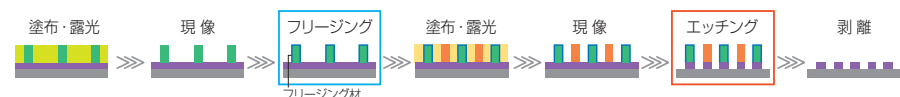
#### 二重露光技術のプロセスフロー (例)

※ 二重露光技術: 目的とするパターンを 2 回に分けて形成する技術。

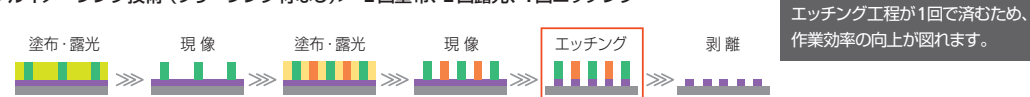
##### <ダブルパターンング技術> 2 回塗布、2 回露光、2 回エッチング



##### <ダブルイメージング技術 (フリージング材あり)> 2 回塗布、2 回露光、1 回エッチング



##### <ダブルイメージング技術 (フリージング材なし)> 2 回塗布、2 回露光、1 回エッチング



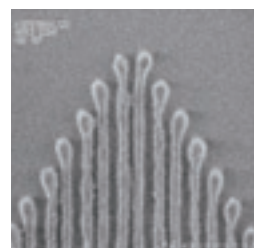
ダブルイメージング技術では、エッチング工程が 1 回で済むため、作業効率の向上が図れます。

\*1 ポジ型フォトレジスト: 露光した後に現像を行うと、露光されなかった部分がパターンとして残るフォトレジスト。

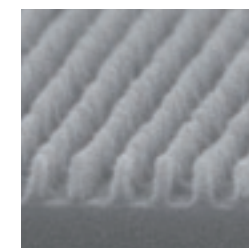
\*2 ネガ型フォトレジスト: 露光した後に現像を行うと、露光された部分がパターンとして残るフォトレジスト。

\*3 フリージング材: 2 回目のフォトレジスト塗布時に、すでにパターン形成されたフォトレジストが溶解しないようにその表面部を保護する材料。

\*4 IMEC: マイクロエレクトロニクス、ナノテクノロジー等の分野で研究を行っている欧州の独立研究機関。



回路線幅 32nm  
(写真ご提供: IMEC\*4)



回路線幅 25nm  
(写真ご提供: IMEC)



モールド



転写パターン

(写真ご提供: 兵庫県立大学 松井教授、中松様)

Special Feature :  
特集: 微細加工技術の未来を追求する

### ■ 高解像度、高感度、ラフネス低減を同時に実現——EUV 露光技術への対応

さらなる微細化に向けて一挙に短波長化を進め、波長 13.5nm の EUV (極端紫外線) による露光が検討されています。回路線幅 22nm 世代の半導体の製造開始が予想される 2013 年の導入に向けて、現在、フォトレジストメーカー、露光装置メーカー等が研究開発を行っています。

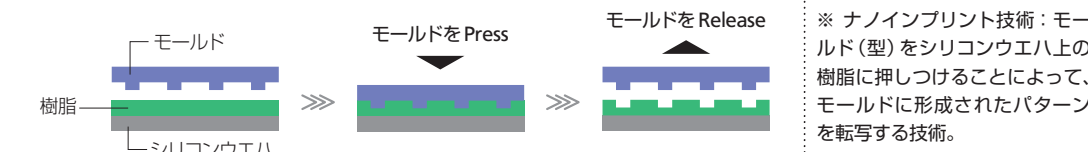
当社では、低分子ポリフェノールや酸発生剤を新規に開発するなど、EUV 用フォトレジストの高機能化に取り組み、コンソーシアム等との連携も積極的に進めています。これまで技術的に困難だと考えられていた高解像度、高感度、ラフネス (パターンの粗さ) 低減の 3 つの特性を同時に実現するフォトレジストの開発に目処をつけ、すでにサンプル出荷を開始し、世界でもトップレベルの高い評価を得ています。

### ■ 次々世代の新技术——ナノインプリント技術\*への対応

従来のフォトリソグラフィとはまったく異なる工法であるナノインプリント技術。プロセスが非常にシンプルであることに加え、低コストで複雑かつ微細なパターンを形成できることから、さらなる微細化を実現する新技术として注目されています。

当社では、モールド (型) を押しつける際に加熱処理や紫外線照射を必要としない、室温ナノインプリントに適した樹脂の開発を行っています。次々世代の微細加工技術に求められる材料として今後も研究開発を進めるとともに、マイクロレンズ、記録メディア、MEMS (微小電気機械システム) 等、半導体以外の分野への展開も図っていきます。

#### 室温ナノインプリントのプロセスフロー



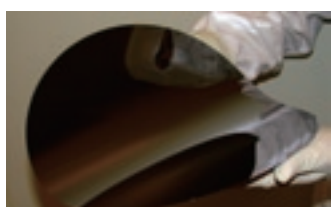
※ ナノインプリント技術: モールド (型) をシリコンウエハ上の樹脂に押しつけることによって、モールドに形成されたパターンを転写する技術。

### シリコン貫通電極形成プロセスを可能に——ウエハハンドリングシステム「Zero Newton®」※

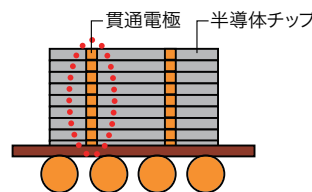
シリコン貫通電極は、半導体パッケージ分野において、次世代を担うキー・テクノロジーの 1 つと考えられています。特に回路線幅 32nm 世代以降では、半導体チップを薄片化して積み重ね、貫通電極を形成することによってデバイスの高密度化、小型化を図る動きが加速すると見られます。

新たに開発したウエハハンドリングシステム「Zero Newton®」は、半導体チップの薄片化に伴う強度の低下により割れや欠けが生じるという問題を、シリコンウエハにサポート板を貼り付け強度を持たせることで解決し、貫通電

#### 薄片化されたシリコンウエハ



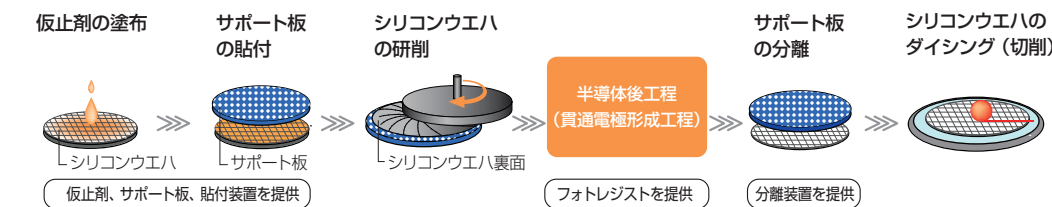
#### 貫通電極を用いた半導体パッケージの概略図



極の形成を容易に行うことを可能にする技術です。貫通電極形成後は、サポート板にある無数の穴から溶剤を染み込ませ仮止剤を溶かすことで、簡単にシリコンウエハとサポート板を分離させることができます。サポート板や仮止剤といった材料のほか、これらの使用工程に対応した装置も開発するなど、当社の強みである「M&E (Materials & Equipment) 戦略」による展開を推進しています。

※シリコンウエハにストレスを与えることなくサポート板を分離することができ、力を加えることなく処理ができることから「Zero Newton®」と名づけました。

#### ウエハハンドリングシステム「Zero Newton®」のプロセスフロー







# 財務セクション

## 6年間の要約財務データ

東京応化工業株式会社および連結子会社

2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年の3月31日に終了した各会計年度

(百万円)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>会計年度</b>						
売上高	72,286	83,121	88,960	98,514	101,955	<b>102,300</b>
材料事業	62,721	66,927	71,617	80,338	83,038	<b>86,071</b>
装置事業	9,644	16,263	17,461	18,252	18,991	<b>16,298</b>
営業利益	4,563	5,703	7,295	10,544	10,884	<b>8,266</b>
経常利益	4,838	6,036	8,051	11,156	11,677	<b>7,674</b>
税金等調整前当期純利益	3,885	8,372	8,070	11,324	11,119	<b>7,352</b>
当期純利益	1,924	4,751	5,088	6,656	6,660	<b>4,259</b>
設備投資額	8,019	4,131	3,631	6,962	8,531	<b>6,574</b>
減価償却費	5,232	5,810	5,595	5,502	5,931	<b>7,693</b>
研究開発費	6,028	6,744	5,800	5,683	6,487	<b>8,095</b>

### 1株当たり情報(円)

1株当たり当期純利益	39.12	98.69	109.16	142.34	142.37	<b>91.50</b>
1株当たり配当金	20.00	22.00	27.00	33.00	36.00	<b>36.00</b>
1株当たり純資産	2,290.90	2,401.31	2,492.60	2,650.50	2,750.81	<b>2,775.38</b>

### 会計年度末

総資産	141,402	146,376	154,309	165,681	166,610	<b>159,633</b>
固定負債	7,954	6,564	7,086	2,222	2,108	<b>2,198</b>
純資産	111,241	111,301	115,564	123,915	131,074	<b>129,834</b>

### 指標(%)

売上高営業利益率	6.3	6.9	8.2	10.7	10.7	<b>8.1</b>
売上高経常利益率	6.7	7.3	9.1	11.3	11.5	<b>7.5</b>
売上高研究開発費比率	8.3	8.1	6.5	5.8	6.4	<b>7.9</b>
自己資本当期純利益率	1.7	4.3	4.5	5.6	5.3	<b>3.3</b>
自己資本比率	78.7	76.0	74.9	74.8	77.3	<b>79.9</b>

※ 1. セグメント間の取引は、相殺消去していません。

※ 2. 2006年3月期以前の純資産、1株当たり純資産、自己資本当期純利益率および自己資本比率は、それぞれの時点での株主資本、1株当たり株主資本、株主資本当期純利益率および株主資本比率を再計算せず、表示しています。

## 業績および財政状態の分析

### 業績の概況

#### 売上高

当期(2008年3月期)の連結売上高は、前期比3億45百万円(0.3%)増加の1,023億円となりました。このうち、上期の売上高は、前年同期比3億67百万円(0.7%)減少の503億29百万円、下期の売上高は、前年同期比7億13百万円(1.4%)増加の519億71百万円となりました。

半導体市場は、メモリの過剰供給による価格下落が見られましたが、新型機種デジタル家電や情報関連機器の需要拡大、省エネルギー技術を搭載する自動車への半導体の用途拡大等から安定した成長が続きました。また、フラットパネルディスプレイ市場も、販売価格下落の影響がありましたものの、薄型テレビ等の需要拡大に支えられ概ね順調に推移しました。

このような状況の下、わずかではありますが増収を確保することができました。

#### セグメント別分析

※セグメント間の取引は、相殺消去していません。

#### 事業の種類別セグメント情報

当期における材料事業の売上高は、高純度化学薬品部門および印刷材料部門は減少しましたが、エレクトロニクス機能材料部門の増加がこれを補い、前期比30億32百万円(3.7%)増加の860億71百万円となりました。利益面では、減価償却費の増加、為替相場の変動等の影響により、営業利益は前期比10

億38百万円(8.2%)減少の115億75百万円となりました。

また、装置事業の売上高は、前期比26億92百万円(14.2%)減少の162億98百万円となりました。利益面では、売上高の減少や貸倒引当金繰入額の計上等により、営業利益は前期比17億29百万円(57.5%)減少の12億77百万円となりました。

#### 【材料事業】

当事業は、主として「エレクトロニクス機能材料部門」「高純度化学薬品部門」および「印刷材料部門」により構成されています。

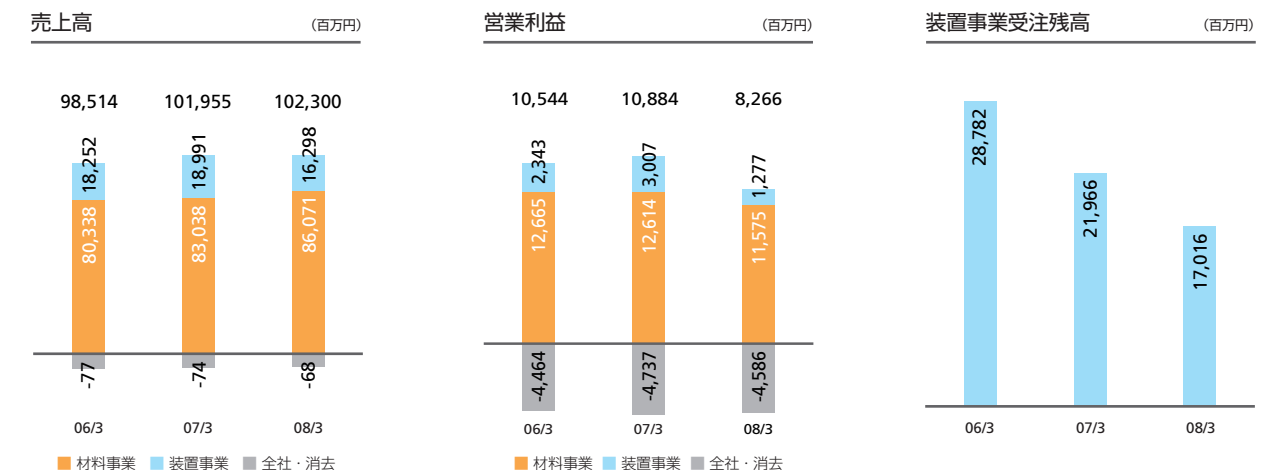
#### ■エレクトロニクス機能材料部門

エレクトロニクス機能材料部門の売上高は、前期比34億59百万円(6.8%)増加の540億73百万円となりました。

半導体用フォトレジストは、新型機種のパソコンや携帯電話等の需要が拡大する中、国内外市場でのきめ細かな販売促進活動により、エキシマレーザー用フォトレジストを中心に実績を伸ばしました。

また、フラットパネルディスプレイ用フォトレジストは、プラズマディスプレイ用フォトレジストが需要の減少により低調に推移しましたが、液晶ディスプレイ用フォトレジストは製品価格下落の影響がありましたもののアジア地域におけるユーザーニーズを捉えた製品の販売が奏功し前期を上回る実績をあげ、概ね堅調に推移しました。

加えて、被膜形成用塗布液につきましても、アジア地域を中心に売上が増加しました。



## ■高純度化学薬品部門

高純度化学薬品部門の売上高は、前期比1億53百万円(0.6%)減少の275億21百万円となりました。

無機化学薬品・有機化学薬品は、国内での需要拡大を的確に捉え前期の売上を上回りました。また、半導体用フォトレジスト付属薬品は、アジア、北米地域を中心に売上を伸ばすことができました。一方、フラットパネルディスプレイ用フォトレジスト付属薬品につきましては、競争激化による製品価格下落の影響を受け、低調に推移しました。

## ■印刷材料部門

印刷材料部門の売上高は、前期比2億64百万円(5.8%)減少の43億36百万円となりました。

印刷用感光性樹脂版につきましては、フレキシ印刷向けがアジア地域で実績を伸ばしたものの、欧州、北米地域における需要環境の変化等により売上は減少しました。また、一般印刷向けも欧州地域において製品価格の是正を行った影響から苦戦を強いられ、売上は前期を下回りました。

## 【装置事業】

当事業は、「プロセス機器部門」により構成されています。

## ■プロセス機器部門

プロセス機器部門の売上高は、前期比26億92百万円(14.2%)減少の162億98百万円となりました。

液晶パネル製造装置は、液晶パネルメーカーにおける設備投資抑制の影響から受注および売上とも前期を下回りました。

方、半導体製造装置につきましては、ドライアッシング装置、塗布装置が国内を中心に売上は前期を上回りました。

同部門の受注高は、前期比6.6%減少の112億79百万円となりました。上期の受注高は33億24百万円にとどまりましたが、下期の受注高は79億56百万円と大幅に回復させることができました。また、期末時点での受注残高は、前期末比22.5%減少の170億16百万円となりました。

## 所在地別セグメント情報

### ■日本

デジタル家電やIT関連機器等の需要拡大に支えられ、エキシマレーザー用フォトレジストを中心に材料事業の売上は増加しました。一方、装置事業は、液晶パネル製造装置等の売上が減少したことにより、売上高は前期比5億51百万円(0.6%)増加の866億99百万円となりました。利益面では、材料事業において開発投資に伴う減価償却費の負担が増加し、また、装置事業の売上減少等の影響も大きく、営業利益は前期比26億44百万円(27.5%)減少の69億82百万円となりました。

### ■北米

フォトレジスト付属薬品の売上増加等はありませんものの、一部フォトレジストの売上減少と為替相場の変動の影響により、売上高は前期比3億87百万円(4.0%)減少の93億5千万円となりました。利益面では、現地生産製品の利益率の上昇等により、営業利益は前期比1億5百万円(12.6%)増加の9億46百万円となりました。

## ■欧州

欧州市場での需要が低調に推移したことなどにより、半導体材料、印刷材料とも売上が減少し、売上高は前期比2億34百万円(3.4%)減少の66億55百万円となりました。利益面でも、売上高の減少等により、前期8千万円の営業利益から当期は1億27百万円の営業損失となりました。

## ■アジア

韓国子会社および中国子会社におけるフォトレジスト付属薬品の売上増加等により、売上高は前期比3億72百万円(3.0%)増加の127億74百万円となりました。利益面では、利益率の高い製品の売上が減少したことなどにより、営業利益は前期比4億61百万円(29.1%)減少の11億27百万円となりました。

## 売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益

当期の売上原価は、前期比7億55百万円(1.1%)増加の700億3百万円、売上原価率は、製品販売価格の下落や為替相場の変動の影響等により、前期比0.5ポイント上昇の68.4%となりました。これに伴い、売上総利益は、前期比4億9百万円(1.3%)減少の322億97百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、減価償却費の増加、貸倒引当金繰入額の計上等により、前期比22億7百万円(10.1%)増加の240億3千万円となりました。

営業利益は、売上総利益の減少および販売費及び一般管理費の増加により、前期比26億17百万円(24.1%)減少の82億66百万円、売上高営業利益率は、前期比2.6ポイント低下の8.1%となりました。

## 経常利益、税金等調整前当期純利益、当期純利益

経常利益は、営業外収益は前期と同水準でありましたものの、為替差損や持分法による投資損失、たな卸資産評価損の計上等により、前期比40億3百万円(34.3%)減少の76億74百万円、売上高経常利益率は、前期比4.0ポイント低下の7.5%となりました。

税金等調整前当期純利益は、海外子会社の清算に伴う為替換算調整勘定取崩額や固定資産売却益の増加等があったものの、投資有価証券評価損や減損損失の計上等により、前期比37億67百万円(33.9%)減少の73億52百万円となりました。

当期純利益は、前期比24億1百万円(36.1%)減少の42億59百万円、売上高当期純利益率は前期比2.3ポイント低下の4.2%となりました。

## 財政状態およびキャッシュ・フロー

### 財政状態

当期末(2008年3月31日)現在の資産合計は、前期末比69億77百万円減少の1,596億33百万円となりました。

流動資産は、前期末比47億33百万円減少の954億13百万円となりました。これは、現金及び預金が12億59百万円増加しましたが、装置事業の製品在庫の減少等により、たな卸資産が54億65百万円減少したことが主な要因です。

固定資産につきましても、前期末比22億44百万円減少の642億19百万円となりました。これは、減価償却の進行により有形固定資産が6億97百万円、無形固定資産が5億77百万円それぞれ減少し、また、株式の時価下落等により投資有価証券が17億8千万円減少したことが主な要因です。

当期末の負債合計は、前期末比57億36百万円減少の297億99百万円となりました。これは、装置事業の出荷減少等により前受金が49億4千万円、設備関係の未払金の減少等により未払金が14億99百万円それぞれ減少したことが主な要因です。

当期末の純資産合計は、当期純利益42億59百万円がありましたものの、剰余金の配当や自己株式の取得等により、前期末比12億4千万円減少の1,298億34百万円となりました。

この結果、当期末の自己資本比率は79.9%となりました。

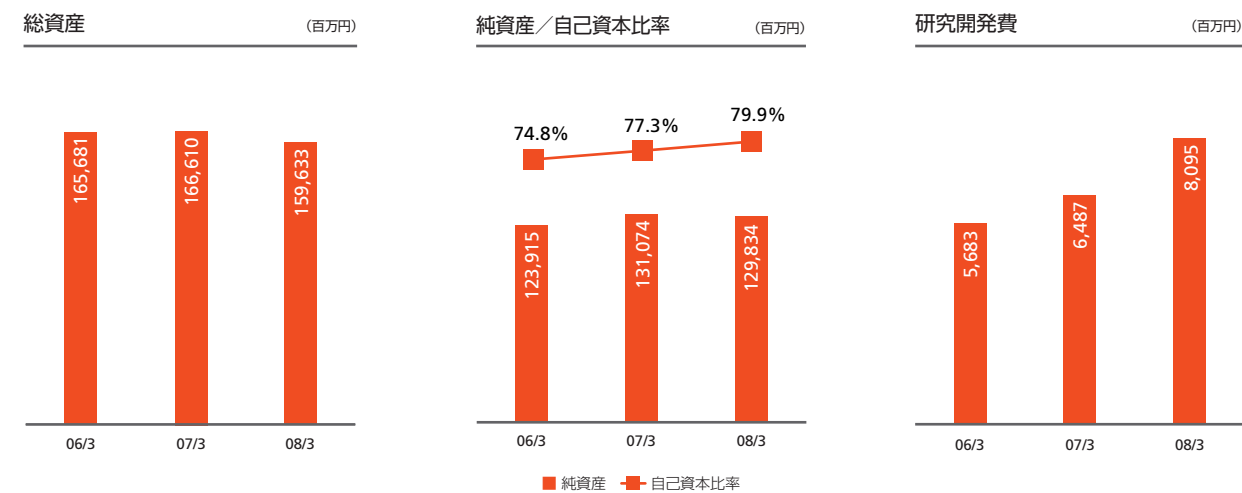
### キャッシュ・フロー

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比60億94百万円増加の148億39百万円の資金収入となりました。これは、減価償却費の増加やたな卸資産の減少、仕入債務の増加等により資金収入が増加したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比71億85百万円増加の230億8百万円の支出となりました。これは、定期預金の増加による支出等が増加したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前期比25億21百万円増加の39億9千万円の支出となりました。これは、自己株式の取得による支出や配当金の支払等によるものです。

これらの活動の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末の325億69百万円から130億29百万円減少し195億39百万円となりました。



連結貸借対照表

2007年および2008年3月31日現在

(百万円)

区 分	2007		2008		構成比 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
(資産の部)					
<b>流動資産</b>					
現金及び預金	37,429		<b>38,689</b>		
受取手形及び売掛金	31,130		<b>31,485</b>		
たな卸資産	28,048		<b>22,583</b>		
繰延税金資産	1,918		<b>1,796</b>		
その他	1,725		<b>1,042</b>		
貸倒引当金	△105		<b>△182</b>		
流動資産合計	100,147	60.1	<b>95,413</b>	59.8	
<b>固定資産</b>					
有形固定資産					
建物及び構築物	55,910		<b>57,739</b>		
減価償却累計額	35,027	20,883	<b>36,705</b>	<b>21,034</b>	
機械装置及び運搬具	44,120		<b>47,949</b>		
減価償却累計額	34,128	9,991	<b>36,641</b>	<b>11,307</b>	
工具器具備品	15,659		<b>16,372</b>		
減価償却累計額	11,809	3,849	<b>13,122</b>	<b>3,250</b>	
土地		9,475		<b>9,126</b>	
建設仮勘定		1,776		<b>559</b>	
有形固定資産合計	45,976	27.6	<b>45,278</b>	28.4	
無形固定資産	1,596	1.0	<b>1,019</b>	0.6	
投資その他の資産					
投資有価証券	7,427		<b>5,646</b>		
長期貸付金	17		<b>17</b>		
繰延税金資産	953		<b>1,759</b>		
長期性預金	10,000		<b>10,000</b>		
その他	503		<b>1,058</b>		
貸倒引当金	△10		<b>△560</b>		
投資その他の資産合計	18,890	11.3	<b>17,921</b>	11.2	
固定資産合計	66,463	39.9	<b>64,219</b>	40.2	
<b>資産合計</b>	166,610	100.0	<b>159,633</b>	100.0	

(百万円)

区 分	2007		2008		構成比 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
(負債の部)					
<b>流動負債</b>					
支払手形及び買掛金	10,019		<b>10,651</b>		
未払金	5,121		<b>3,621</b>		
未払法人税等	1,101		<b>985</b>		
繰延税金負債	62		<b>66</b>		
前受金	12,904		<b>7,963</b>		
賞与引当金	1,731		<b>1,702</b>		
役員賞与引当金	20		<b>16</b>		
製品保証引当金	126		<b>112</b>		
その他	2,339		<b>2,479</b>		
流動負債合計	33,427	20.0	<b>27,600</b>	17.3	
<b>固定負債</b>					
長期借入金	220		<b>166</b>		
繰延税金負債	568		<b>526</b>		
退職給付引当金	1,113		<b>1,258</b>		
役員退職慰労引当金	174		<b>216</b>		
その他	31		<b>31</b>		
固定負債合計	2,108	1.3	<b>2,198</b>	1.4	
<b>負債合計</b>	35,535	21.3	<b>29,799</b>	18.7	
(純資産の部)					
<b>株主資本</b>					
資本金	14,640	8.8	<b>14,640</b>	9.2	
資本剰余金	15,226	9.1	<b>15,207</b>	9.5	
利益剰余金	96,472	57.9	<b>99,043</b>	62.0	
自己株式	△1,414	△0.8	<b>△3,569</b>	△2.2	
株主資本合計	124,925	75.0	<b>125,321</b>	78.5	
<b>評価・換算差額等</b>					
その他有価証券評価差額金	3,104	1.8	<b>1,890</b>	1.2	
為替換算調整勘定	794	0.5	<b>323</b>	0.2	
評価・換算差額等合計	3,899	2.3	<b>2,213</b>	1.4	
<b>少数株主持分</b>	2,249	1.4	<b>2,298</b>	1.4	
<b>純資産合計</b>	131,074	78.7	<b>129,834</b>	81.3	
<b>負債純資産合計</b>	166,610	100.0	<b>159,633</b>	100.0	



## 連結損益計算書

2007年および2008年3月31日に終了した会計年度 (百万円)

区 分	2007		2008	
	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)
売上高	101,955	100.0	<b>102,300</b>	100.0
売上原価	69,248	67.9	<b>70,003</b>	68.4
売上総利益	32,706	32.1	<b>32,297</b>	31.6
販売費及び一般管理費	21,822	21.4	<b>24,030</b>	23.5
営業利益	10,884	10.7	<b>8,266</b>	8.1
営業外収益				
受取利息	123		<b>285</b>	
受取配当金	84		<b>103</b>	
受取技術援助料	226		<b>184</b>	
受取保険金等	522		<b>195</b>	
特許等使用料返還益	167		—	
受取補償金	—		<b>326</b>	
その他	273	1.4	<b>304</b>	1.3
営業外費用				
支払利息	14		<b>25</b>	
為替差損	—		<b>1,012</b>	
持分法による投資損失	—		<b>222</b>	
たな卸資産廃棄損	75		<b>100</b>	
たな卸資産評価損	—		<b>217</b>	
損害補償料	431		<b>188</b>	
その他	83	0.6	<b>224</b>	1.9
経常利益	11,677	11.5	<b>7,674</b>	7.5
特別利益				
貸倒引当金戻入額	29		<b>1</b>	
固定資産売却益	33		<b>111</b>	
為替換算調整勘定取崩額	—		<b>170</b>	
その他	62	0.0	<b>0</b>	0.3
特別損失				
固定資産除却損	620		<b>154</b>	
減損損失	—		<b>134</b>	
投資有価証券評価損	—		<b>302</b>	
その他	620	0.6	<b>12</b>	0.6
税金等調整前当期純利益	11,119	10.9	<b>7,352</b>	7.2
法人税、住民税及び事業税	3,921		<b>2,983</b>	
法人税等調整額	230	4.1	<b>△84</b>	2.8
少数株主利益	307	0.3	<b>193</b>	0.2
当期純利益	6,660	6.5	<b>4,259</b>	4.2

## 連結株主資本等変動計算書

2008年3月31日に終了した会計年度 (百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
<b>2007年3月31日残高</b>	14,640	15,226	96,472	△1,414	124,925
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△1,686		△1,686
当期純利益			4,259		4,259
自己株式の取得				△2,404	△2,404
自己株式の処分		△18	△2	248	227
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	△18	2,570	△2,155	396
<b>2008年3月31日残高</b>	14,640	15,207	99,043	△3,569	125,321

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計		
<b>2007年3月31日残高</b>	3,104	794	3,899	2,249	131,074
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					△1,686
当期純利益					4,259
自己株式の取得					△2,404
自己株式の処分					227
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△1,214	△471	△1,685	48	△1,637
連結会計年度中の変動額合計	△1,214	△471	△1,685	48	△1,240
<b>2008年3月31日残高</b>	1,890	323	2,213	2,298	129,834

## 連結キャッシュ・フロー計算書

2007年および2008年3月31日に終了した会計年度

(百万円)

区分	2007	2008
	金額	金額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	11,119	<b>7,352</b>
減価償却費	5,931	<b>7,693</b>
減損損失	—	<b>134</b>
貸倒引当金の増減額(減少額は△)	△29	<b>627</b>
賞与引当金の増減額(減少額は△)	193	△ <b>28</b>
役員賞与引当金の増減額(減少額は△)	20	△ <b>4</b>
製品保証引当金の増減額(減少額は△)	1	△ <b>14</b>
退職給付引当金の増減額(減少額は△)	△107	<b>139</b>
役員退職慰労引当金の増減額(減少額は△)	△362	<b>41</b>
受取利息及び受取配当金	△207	△ <b>389</b>
支払利息	14	<b>25</b>
為替差損益(差益は△)	△431	<b>548</b>
持分法による投資損失	—	<b>222</b>
固定資産売却益	△33	△ <b>111</b>
固定資産除却損	620	<b>154</b>
投資有価証券評価損	—	<b>302</b>
売上債権の増加額	△1,414	△ <b>439</b>
たな卸資産の減少額	1,662	<b>5,440</b>
仕入債務の増減額(減少額は△)	△1,495	<b>667</b>
前受金の増減額(減少額は△)	300	△ <b>4,940</b>
役員賞与の支払額	△33	—
その他	△1,110	<b>67</b>
小計	14,636	<b>17,492</b>
利息及び配当金の受取額	196	<b>380</b>
利息の支払額	△13	△ <b>25</b>
法人税等の支払額	△6,074	△ <b>3,007</b>
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,744	<b>14,839</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の純増減額	△1,568	△ <b>9,343</b>
有形固定資産の取得による支出	△8,904	△ <b>7,953</b>
無形固定資産の取得による支出	△144	△ <b>128</b>
投資有価証券の取得による支出	△193	△ <b>602</b>
長期性預金の預入による支出	△5,000	△ <b>5,000</b>
その他	△11	<b>19</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,822	△ <b>23,008</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入れによる収入	215	—
長期借入金の返済による支出	△0	—
配当金の支払額	△1,679	△ <b>1,670</b>
少数株主への配当金の支払額	△146	△ <b>108</b>
自己株式の売却による収入	176	<b>227</b>
自己株式の取得による支出	—	△ <b>2,410</b>
その他	△34	△ <b>29</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,469	△ <b>3,990</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	295	△ <b>869</b>
現金及び現金同等物の減少額	△8,250	△ <b>13,029</b>
現金及び現金同等物の期首残高	40,820	<b>32,569</b>
現金及び現金同等物の期末残高	32,569	<b>19,539</b>

## Global Network :

# グローバル・ネットワーク



## ホームページ上のIR情報

<http://www.tok.co.jp/>

- 株主・投資家の皆様へ
- 動画配信
  - 機関投資家・アナリスト向け決算説明会、
  - 会社案内ビデオ(日本語、英語、中国語、韓国語)
- 株式情報
  - 株式の状況、株価情報、配当金の推移
- IRカレンダー
  - 業績の概要推移、決算短信
- IRライブラリ
  - アニュアルレポート、報告書、有価証券報告書等、
  - 説明会資料
- 株式に関するお手続き
- 電子公告
- 今日の株価
- FAQ(よくあるご質問)
- IRお問い合わせ窓口



トップページ



IR情報

私たちの仕事

# 会社情報

## 会社概要 (2008年3月31日現在)

社名： 東京応化工業株式会社  
 設立： 1940年10月25日  
 本社： 〒211-0012  
 川崎市中原区中丸子150  
 従業員数： 1,850名(連結)  
 資本金： 146億4,044万8千円  
 ホームページ： <http://www.tok.co.jp/>  
 上場証券取引所： 東京証券取引所市場第一部  
 お問い合わせ先： 広報部  
 〒211-0012  
 川崎市中原区中丸子150  
 TEL. 044-435-3000  
 FAX. 044-435-3020



## 役員一覧 (2008年6月26日現在)

### 取締役

代表取締役 取締役社長	執行役員社長	中村 洋一	
代表取締役	専務執行役員	小峰 孝	材料事業本部長
代表取締役	専務執行役員	開発 宏一	総務本部長
取締役	執行役員	岩崎 光文	営業本部長
取締役	執行役員	大田 勝行	経営企画室長兼企画部長
取締役	執行役員	小原 秀克	開発本部長兼開発企画室長
取締役		牧野 二郎 <sup>※1</sup>	株式会社牧野フライス製作所取締役社長

### 監査役

常勤監査役	逸見 至保	
監査役	榎垣 不二夫 <sup>※2</sup>	菱進ホールディングス株式会社取締役社長 菱進都市開発株式会社取締役社長
監査役	羽山 幸男 <sup>※2</sup>	国際保険株式会社監査役

### 執行役員

専務執行役員	堀越 昭則	経理本部長兼財務部長
常務執行役員	任田 博行	TOKYO OHKA KOGYO EUROPE B.V. 取締役社長
執行役員	古谷 仁	調達本部長
執行役員	田澤 賢二	プロセス機器事業本部長
執行役員	浅羽 洋	材料事業本部副本部長
執行役員	駒野 博司	TOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC. 取締役社長

※1. 取締役 牧野二郎氏は社外取締役です。  
 ※2. 監査役 榎垣不二夫および監査役 羽山幸男の両氏は社外監査役です。

# 株式の概況 (2008年3月31日現在)

## 株式の状況

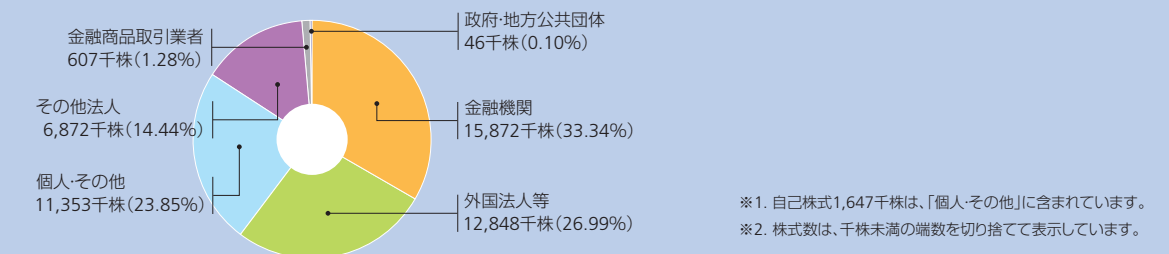
発行可能株式総数： 197,000,000株  
 発行済株式の総数： 47,600,000株 (自己株式1,647,523株を含む)  
 株主数： 10,418名

## 大株主 (上位10名)

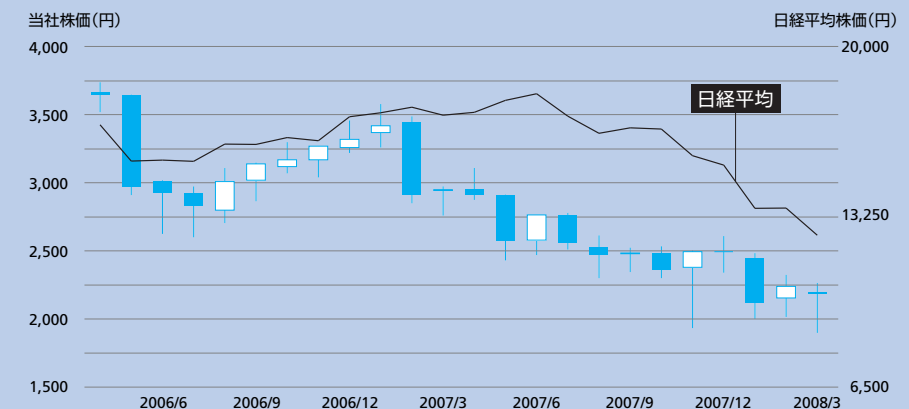
株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,965	6.45
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,169	4.72
明治安田生命保険相互会社	2,148	4.68
エムエルピーエフエスカस्टディー	1,497	3.26
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 505019	1,417	3.08
株式会社横浜銀行	1,283	2.79
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,207	2.63
財団法人東京応化科学技術振興財団	984	2.14
三菱UFJ信託銀行株式会社	953	2.08
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	890	1.94

※1. 当社は、自己株式を1,647千株保有していますが、上記大株主から除いています。  
 ※2. 持株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しています。  
 ※3. 出資比率は、発行済株式の総数から自己株式を除いた株式数(45,952,477株)を基準に算出しています。

## 所有者別株式分布状況



## 株価の推移



**将来見通しに関する注意事項**  
 本アニュアルレポートに記載の将来に対する見通し、予想等につきましては、その時点までに入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。したがって、実際の業績は様々な重要な要因により、この業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性があるため、この業績見通しに全面的に依拠されませんよう、お願いいたします。また、その時点以降に修正されている場合があるため、最新の資料をご入手いただくなど、必ずご確認いただけますよう、お願いいたします。



## **tok** 東京応化工業株式会社

〒211-0012 川崎市中原区中丸子150

TEL. 044-435-3000 (代表)

FAX. 044-435-3020

<http://www.tok.co.jp/>



環境に配慮した大豆油インキを使用しています。  
08.08 500 NIR. AUMZ